

2SC2274 (3DG2274)

2SC2274K (3DG2274K)

硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN TRANSISTOR

用途:用于低频功率放大。

Purpose: Low frequency power amplifier applications.

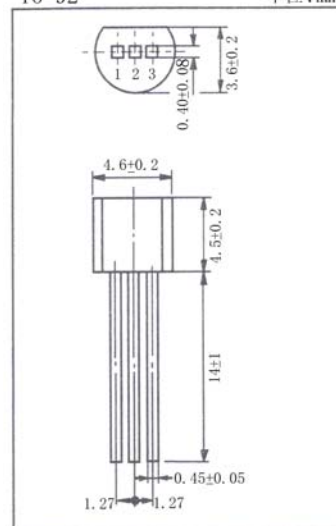
特点: 高电压, 大电流, 低饱和压降。

Features: High breakdown voltage, high current, low saturation voltage.

极限参数/Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit	
V _{CBO}	2SC2274 2SC2274K	60 100	V
V _{CEO}	2SC2274 2SC2274K	50 80	V
V _{EBO}		5.0	V
I _C		500	mA
I _{CP}		800	mA
P _C		600	mW
T _j		150	°C
T _{stg}		-55~150	°C

T0-92 单位:mm



引脚: 1. E 2. C 3. B

电性能参数/Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数符号 Symbol	测试条件 Test Condition	数值 Symbol			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V _{CBO}	2SC2274 2SC2274K I _C =10 μA I _E =0	60 100			V
V _{CEO}	2SC2274 2SC2274K I _C =1.0mA R _{BE} =∞	50 80			V
V _{EBO}	I _E =10 μA I _C =0	5.0			V
I _{CBO}	V _{CB} =40V I _E =0			1.0	μA
I _{EBO}	V _{EB} =4.0V I _C =0			1.0	μA
h _{FE(1)}	V _{CE} =5.0V I _C =50mA	60		320	
h _{FE(2)}	V _{CE} =5.0V I _C =400mA	35			
V _{CE(sat)}	I _C =400mA I _B =40mA		0.2	0.6	V
V _{BE(sat)}	I _C =400mA I _B =40mA		0.9	1.2	V
f _T	V _{CE} =10V I _C =10mA		120		MHz
C _{ob}	V _{CB} =10V f=1.0MHz		5.0		pF

h_{FE(1)}分档/h_{FE(1)} Classifications: D:60~120 E:100~200 F:160~320

2SC2274 (3DG2274)
2SC2274K (3DG2274K)

